

Siウエハ ベベル部の汚染評価

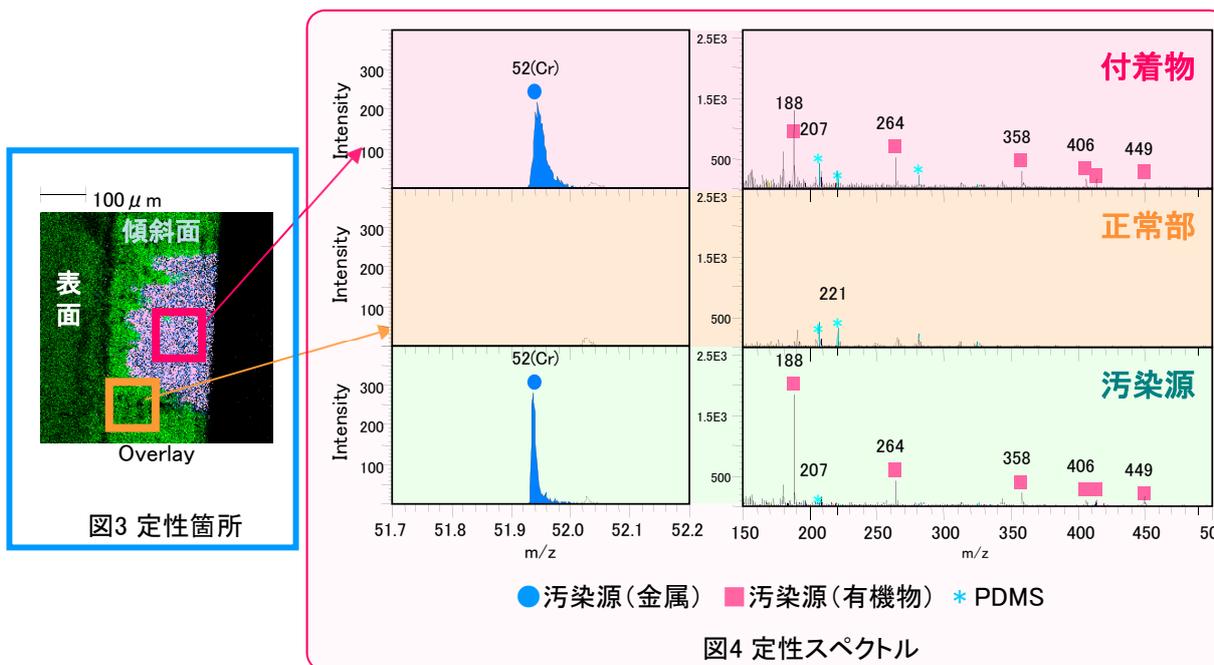
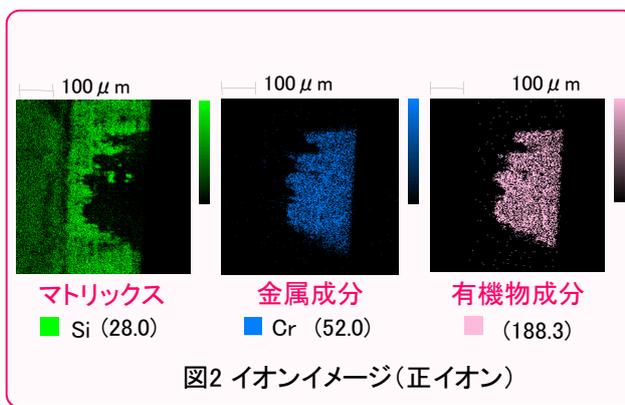
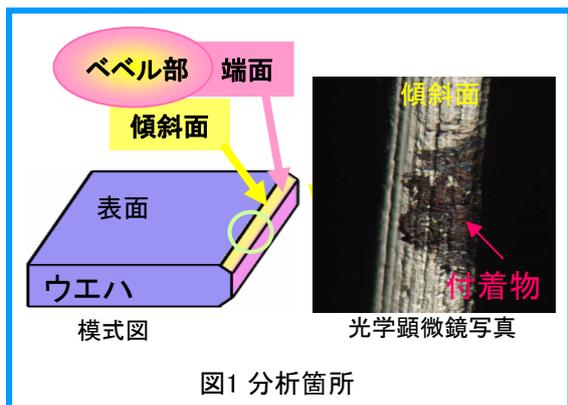
金属成分と有機成分を同時に評価可能です

測定法 : TOF-SIMS
 製品分野 : LSI・メモリ・パワーデバイス・光デバイス
 分析目的 : 組成評価・同定・組成分布評価

概要

半導体デバイス製造において、歩留まり向上の観点から、ウエハの裏面の清浄度向上に加え、ウエハのベベル部に残留する物質を除去することが求められています。今回、ベベル傾斜面のTOF-SIMS分析を行い、汚染の分布を評価しました(図2)。また、付着物と正常部・汚染源のマススペクトルを比較し、付着物は汚染源の金属(Cr)成分・有機物成分と一致していることがわかりました。TOF-SIMSにてベベル部(端面と傾斜面)の汚染の発生工程を捉える事が可能です。

データ



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート!

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
 URL : <https://www.mst.or.jp/>